







	美型 PB型大电流磁 珠	Comment 600Ω@100MHz	型号 PB2012-601/1A5	Description 600Ω @ 100MHz ±25%	B1, B2, B3, B4	Quantity 4	万家 振华富	订货编码	封装 0805
2	味 片式多层瓷介电 容器	10uF	QJB/K-CT41G- 0805-X5R-25V- 106-M-N, QJB/K+- CT41G-0805-X7R-	10uF,二类,±20%,25V,-55~125°C, 10uF, 二类,±20%,10V,-55~125°C	C1, C7, C8, C11, C12, C14, C15, C16, C17, C19, C20, C26, C33, C42, C44, C48,	18	火炬	/	0805
3	片式多层能介电	100nF	10V-106-M-N	100nF,二类,±10%,50V,-55~125°C	C52, C56 C2, C9, C13, C23, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C34, C35, C36, C37, C38, C39	33	火炬	,	0603
	容器		0603-X7R-50V- 104-K-N		C40, C41, C43, C45, C47, C49, C50, C51, C53, C54, C55, C57, C58, C61, C62, C68, C69				
4	片式多层瓷介电 容器	1nF	QJB/K+-CT41G- 0603-X7R-50V- 102-K-N	1nF,二类,±10%,50V,-55~125°C	C3	1	灺	,	0603
5	片式多层瓷介电 容器	100pF	102-K-N QJB/K+-CC41- 0603-CG-50V-101- J-N	100pF,—௲,±5%,50V,-55~125℃	C4, C24, C63, C64, C65, C66, C67	7	썼	,	0603
6	CAK55聚合物但 电容	100uF	CAK55-H-16V- 100:uF-K	CAK55 有失效率等级的导电聚合物片式 恒电容器	C5, C6	2	振华新云		CASE- E_7343
7	片式多层瓷介电 容器	1uF	QJB/K+-CT41G- 0603-X7R-25V- 105-K-N	1uF,二类,±10%,25V,-55~125℃	C10	1	火炬	,	0603
8	片式多层瓷介电 容器	22uF	QJB/K+-CT41G- 0805-X7R-25V-	22uF,二类,±20%,25V,-55~125°C	C18	1	火炬	,	0805
9	片式多层姿介电	10nF	226-M-N QJB/K+-CT41G- 0603-X7R-50V-	10nF,二类,±10%,50V,-55~125°C	C21, C59	2	火炬	,	0603
	容器 片式多层瓷介电		103-K-N QJB/K-CT41G- 0805-X5R-10V-						
10	容器 金属化聚酯薄膜	22uF	226-M-N GCI 22:	22uF,二类,±20%,10V,-55~125℃	C46	1	火炬		0805
11	並属化聚酯薄膜 电容	470nF/聚酯	12.5X14.4X4.8- 100V-474-J	聚酯薄膜电容 毒液后内容(C/V) 40V	C60	1	振华新云	/	P=10mm
12	尚特基二极管	B340A-13-F	B340A-13-F	直流反向耐圧 (Vr) 40V 平均整流电流 (lo) 3A 正向圧降 (Vf) 550mV @ 3A	D2, D3, D4, D5	4	DIODES(美 台)	C85098	SMA
13	NR型功率电感 器 PB型大电流磁	4.7uH	NR252012-4R7M	电感值 4.7uH	L1, L2, L9 L3, L4, L5, L6, L7,	3	振华富		NR2520
14	珠 Inductor	1000Ω@100MHz 2.2uH	PB3216-102/1A0 SPH201610U2R2M	1000Ω @ 100MHz ±25% 精度 ±20%	L10, L11 L8, L12	7	振华富 Sunlord(順	C96796	1206 NR2016
16	MOS(场效应管)	DMG6968UDM-7	DMG6968UDM-7	震源电圧 (Vdss) 20V 连续調扱电流 (Id) (25°C 計) 6.5A 槽源板調値电圧 900mV @ 250uA 調源等通电阻 24mD @ 6.5A,4.5V 最大功率耗散 (Ta-25°C) 850mW	Q1	1	格) DIODES(美 台)	C151635	SOT23-6
17	PNP	MMBT3906TT1G	MMBT3906TT1G	服入の手柱版 (Han29 C) 650HW 是型 別公園 (Han29 E) 銀定功率 200mW 集申扱电流 (C 200mA 集射扱击管理ULT (C 40V 固体管理型 PNP	Q2, Q3	2	ON(安森美)	C82042	SOT23-3
18	MOS(场效应管)	FDV301N	FDV301N	震察电压 (Vdss) 25V 连续漏极电流 (Id) (25°C 时) 220mA 標源税調値电圧 1.05V @ 250uA 震源等通电阻 4Ω @ 400mA,4.5V 最大功率耗版 (Ta=25°C) 350mW	Q4	1	ON(安森美)	C15310	SOT-23-3
19	片式膜固定电阻器	470R	*LMS*RMK1608-K- B-4700-F- LMS050101001-	版人の年刊版 (13425 C) 350HW 要型 N均道 470R,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R1, R3	2	718	,	0603
20	片式膜固定电阻 器	2K	2017 "LMS"RMK1608-K- B-2001-F- LMS050101001-	2K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R2, R34	2	718	,	0603
21	片式膜固定电阻 器	10M	"LMS"RMK1608-K- B-1005-F- LMS050101001- 2017	10M,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R4, R6	2	718	,	0603
22	片式膜固定电阻 器	1M	"LMS"RMK1608-K- B-1004-F- LMS050101001- 2017	1M,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R5	1	718	,	0603
23	片式膜固定电阻 器	1R	"LMS"RMK1608-K- B-1R0-F- LMS050101001- 2017 "LMS"RMK1608-K-	1Ω ,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R8	1	718	/	0603
24	片式膜固定电阻 器	649K	B-6493-F- LMS050101001-	649K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R10	1	718	,	0603
25	片式膜固定电阻	OR	2017 "LMS" RMZ1608-B- T-30-Q/RV20573-	<30mΩ	R12, R18	2	718	,	0603
26	器 片式膜固定电阻 器	100K	2010 "LMS"RMK1608-K- B-1003-F- LMS050101001-	100K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R13, R16, R21, R40, R41, R44, R46, R47	8	718	,	0603
27	片式膜固定电阻 器	412K	2017 "LMS"RMK1608-K- B-4123-F- LMS050101001- 2017	412K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R15	1	718	,	0603
28	片式膜固定电阻 器	1.4M	"LMS"RMK1608-K- B-1404-F- LMS050101001- 2017	1.4M,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R17	1	718	,	0603
29	片式膜固定电阻 器	22K	"LMS"RMK1608-K- B-2202-F- LMS050101001- 2017 "LMS"RMK1608-K-	22K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R19	1	718	/	0603
30	片式膜固定电阻 器	150K	B-1503-F- I MS050101001-	150K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R20	1	718	,	0603
31	片式摄图定电阻	47R	2017 "LMS"RMK1608-K- B-470-F-		R22		718		0603
31	8	4/K	LMS050101001- 2017 "LMS"RMK1608-K-	47R,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	RZZ	1	/18		0603
32	片式膜固定电阻 器	330R	B-3300-F- LMS050101001- 2017	330R,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R23	1	718	/	0603
33	片式膜固定电阻器	4.7K	B-4701-F- LMS050101001- 2017 RNK5084-M-E- 4701-F-GJB7690-	4.7K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C 4.7K,±1%,40V,0.1W,±300com/°C	R24, R25, R26, R28, R29	5	718	,	0603
34	电阻网络	4.7K	2012 "LMS"RMK1608-K-	4.7K ,±1%,4UV,U.1W,±3UUppmV°C	R27	1	718		0603
35	片式膜固定电阻 器	1K	B-1001-F- LMS050101001- 2017	1K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R30, R35, R42	3	718	,	0603
36	Resistor	51R	RS-03K51R0FT	精度±1% 温度系数±100ppm/°C	R31	1	FH(Q(\$)	C146828	0603
			"LMS"RMK1608-K-	功率 0.1W 銀值 51Ω		,			
37	片式膜固定电阻 器	30R	B-300-F- LMS050101001-	30R,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R32, R33	2	718	/	0603
	片式摄图定电阻		2017 "LMS"RMK1608-K- B-1002-F-						
38	25	10K	LMS050101001- 2017	10K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R36, R38, R43, R45	4	718	1	0603
39	Resistor	30K S-8261AAJMD-	RS-03K3002FT S-8261AAJMD-	精度 ±1% 单节电池保护芯片 过充4.325V	R37, R39	2	FH(风华) ABLIC(艾普	C140100	0603
40	电池保护芯片	G2JT2S	G2JT2S	过放2.5V 过渡150mV	U1	1	(授料)	C125801	SOT23-6
41	模拟开关 LDO	TPS22917DBVR ADP7182AUJZ-	TPS22917DBVR ADP7182AUJZ-5.0-	2A负载开关	U2 U3	1	TI(德州仪 器) ADI(亚德	C2681320 C514357	SOT:23-6
+2	ш	5.0-R7	R7	-28 V、-200 mA、低噪声线性稳压器 DC-DC芯片 最小输入由压 2 5V	us	-	漢)/LINEAR	JU1930/	JU1-23-6
43	DCDC	TLV61048DBVT	TLV61048DBVT	最小输入电压 2.5V 最大输入电压 5.5V 输出电压 (最小值)固定) 0.6V 输出电压 (最大值) 5.5V 可输出电流 1A 开关工作频率 1.5MHz	U4, U7	2	TI(德州仪 器)	C2071944	SOT-23-6
44	LDO	LP2992AIM5- 5.0/NOPB	LP2992AIM5- 5.0/NOPB	16V 工作中源电流(Max) 4mA 圧降(max) 850mV @ 250mA 輸出电圧(可调) - 静态电流(N) - 最大輸出电流 250mA 輸出配置 正 校設到期(PSRR) 45dB(1kHz)	US	1	TI(個州仪 器)	C130001	SOT-23-6
				T作温度 -40°C - 125°C(T)					-
45	DCDC	TLV62568DBVR	TLV62568DBVR	工作温度 40°C-125°C(T) 給出电压(国史) 5V DC-DC35 最小输入电压 2.5V 最小输入电压 5.5V 输出电压 (最小值图定) 0.6V 输出电压 (最小值) 5.5V	U6, U17	2	TI(德州仪 器)	C163219	SOT-23-6
45	DCDC	TLV62568DBVR EP1C3T100C7N	TLV62568DBVR EP1C3T100C7NA	工作温度 40°C-125°C(T) 始地由F(IRP) 80 DC-DC总并 最小能入地区 2.5V 最小能入地区 5.5V 输出电压(最小值高速) 0.5V 输出电压(最小值 5.5V 可输出电流 1A 开关了中级率 1.5MPセ Cyclone Family, 1.5V PGA, 85 I/O PSG 1.7 III. Commercial Grade	U6, U17 U8	2	TI(德州仪 器)	C163219	
				I TPSIBE 407C-1207C(T) BINHIFT(IRIDIP) VI B			28)	C163219	SOT-23-6
46	FPGA	EP1C3T100C7N EPCS4Si8N	EP1C3T100C7NA	上の選集 - WC-129C(T) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	U8	1	器) INTEL ALTERA(阿		TQFP100
46	FPGA FLASH存储器	EPIC3T100C7N EPCS4SI8N REF3325AIDBZ	EP1C3T100C7NA EPCS4SI8N	下の選集 ペット: 197(T) 動か組入出まる 250 最小組入出まる 250 最小組工まる 250 最小組工を 250 最一を 250 最小組工を 250 是一本 250 是一本 250 是一本 250 是一本 250 是一本 250 是一本 2	U8	1	INTEL ALTERA(阿介特拉) TI(德州仪	C569019	TQFP100
48 49	FLASH好婚器 电源参考 极致转换芯片 并获电压参考	EPICST100CTN EPCS4SI8N REF-3325AIDBZ R AD9240ASZRL LM4091AIM3	BPICSTIDOCINA EPCS4SIBN REFS325AIDB2R AD9240ASZRL	下の選集 ペケー (197(T))	U8 U9 U10, U14 U11	1 1 2	ALTERAGIO TH(衛州位 ADI任 ADI任 TH(衛州位 高) TH(衛州位 高)	. C569019 C69039 C38677	TQFP100 SOIC-8 SOT23-3 MQFP-4
48 49	FLASH狩猎器 电源参考 根数转换芯片	EPIC3T100C7N EPCS4SI8N REF3325AIDBZ AD8240ASZRL	EPICSTIOCTNA EPCS4SIBN REFS3325AIDBZR AD9240A\$ZRL	上の選集 ペイ・139(T(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	U8 U9 U10, U14 U111	1 1 2	ALTERA(阿介特拉) TI(德州位 ADI(亚德诺)	C569019 C69039	TQFP100 SOIC-8 SOT23-3 MQFP-4 SOT-23
46 47 48 49 50	FPGA FLASH野豬器 电源参考 极数转换芯片 并联电压参考 运效 结核功能够大器	EPIC3T100C7N EPCS4SI8N REF3325AIDB2 R AD9240ASZRL LM4091AIM3	EPICSTIOCENA EPCS4SIBN REFS325AID6ZR AD9240ASZRL LM4051AIMG-ADJINOPB TCC00041V4S66T ERSE** AD8256ACPZ WP	Tribially exert. 197(T) Tribially exert. 197(T) British Nation 2 Part 2 Part 197(T) British Nation 2 Part 2 Pa	U8 U9 U10, U14 U11 U11 U12 U13 U15	1 1 1 1 1 1 1	部) INTEL ALTERAIGN 分特拉) TI(衛州公 部) ADI(亚德湖) ADI(亚德湖) ADI(亚德湖) ADI(亚德湖)	C669019 C690039 C38677 C181558 C679145	SOIC-8 SOT23-3 MQFP-44 SOT-23 TSOT-23
48 49 50	FLASH好婚器 电源参考 极致转换芯片 并获电压参考	EPICST100CTN EPCS4SI8N REF-3325AIDBZ R AD9240ASZRL LM4091AIM3	EPICSTIOCENA EPCS4SIBN REF3325AIDBZR AD50240ASZRL LM4051AIMG- ADJINOPB 1 T02604144564T	Tribillar exert. 197(TI) Tribillar exert. 197(TI) British Nat State 197 British Nat St	U8 U9 U10, U14 U11	1 1 2	(2) (NTEL ALTERAGE) (NTEL ALT	. C569019 C69039 C38677	TQFP100 SOIC-8 SOT23-3 MQFP-4 SOT-23